サンビームのXAFS装置



概要

XAFS(X線吸収微細構造)はX線吸収スペクトルに現れる特徴的な構造で、着目する元素の 化学結合状態やその周辺の局所構造に関する情報を得ることができる。サンビームでは触媒、 電池、半導体材料などの解析に幅広く利用されており、一般的な透過法による測定のほか、蛍 光収量法による薄膜・微量元素の測定、ガス反応や加熱中の変化など各種のその場(*in-situ*) 測定が可能である。2008年度からの設備更新では、蛍光X線の高感度検出が可能な19素子 半導体検出器と、これを用いたQuick Scan XAFSを実現するための高速カウンターシステム が導入され、極微量元素に対する感度向上や測定時間の大幅な短縮が図られた。



XAFS (X-ray Absorption Fine Structure)



44ch高速カウンターシステム, 自動ガス混合器,冷凍機(8K~RT), ガス供給・除害装置

応用例

参考: 2009年サンビーム研究発表会(SPring-8産業利用報告会)

■シリコン中のヒ素ドーパントの局所構造解析 ~ 19素子SSDを用いた高感度蛍光収量XAFS

MOSトランジスタの微細化 As-K edge Si(1st) 3x10¹⁵/cm² (15 min) 極浅ソース、ドレインの < 30 nm (Log) 開発では、B, As等の 極微量のドーパントの ゲート電極 < 15 nm [cbs] 2x10¹⁴/cm² (18 min) 結合状態解析が重要 Si(3rd) ゲート 絶縁暗 k³ * X (k) F ドレイン Si(2nd) Intensity 10⁵ Si(4th) 5x1013/cm2 (56 min) 19素子SSD 測定 As-Kor 0.005原子層相当 試料: As注入Si Λ R [Å] 入附外的 As-K α 蛍光X線 As注入量 (測定時間) As注入量が少ないほどSi結晶の乱れが少なく、 X線吸収強度に比例して放出される 12000 11600 11800 12200 12400 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Asの蛍光X線を19素子SSDで検出 Photon Energy [eV] k [Å-1] 多くのAsがSi置換位置に存在(=キャリア活性)。

■液体中の微量セレンの酸化反応解析 ~ 蛍光収量法による in-situ XAFS

測定



燃焼灰や副生品の有効利用、ならびに廃棄物処理の 観点から、微量物質の存在形態や挙動把握が重要 反応中の試料溶液はポンプにより測定セルに導入され 再びポンプを介して反応容器へと戻る。



■リチウムイオン二次電池正極材料の局所構造・結晶構造解析 ~ Quick scan測定によるXAFSとXRDのin-situ 同時測定



100 mg/l

5000 mg/l 0, 500 mg/l

ω MV

温度· 50℃

XAFS装置SG